

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成18年3月30日(2006.3.30)

【公開番号】特開2003-292400(P2003-292400A)

【公開日】平成15年10月15日(2003.10.15)

【出願番号】特願2003-18507(P2003-18507)

【国際特許分類】

C 30 B 29/38 (2006.01)

C 30 B 9/00 (2006.01)

H 01 S 5/343 (2006.01)

【F I】

C 30 B 29/38 D

C 30 B 9/00

H 01 S 5/343 6 1 0

【手続補正書】

【提出日】平成18年2月8日(2006.2.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

反応容器内で、アルカリ金属と少なくともⅢⅢ族金属を含む物質とが混合融液を形成し、該混合融液と少なくとも窒素を含む物質とから、ⅢⅢ族金属と窒素とから構成されるⅢⅢ族窒化物を結晶成長させるⅢⅢ族窒化物結晶成長方法であって、圧力と温度とで規定される領域に対応する結晶成長条件で、ⅢⅢ族窒化物の結晶を成長させることを特徴とするⅢⅢ族窒化物結晶成長方法。

【請求項2】

請求項1記載のⅢⅢ族窒化物結晶成長方法において、結晶成長条件として、圧力と温度とで規定される領域を複数個設けるとき、複数の領域のそれぞれに応じて互いに異なる結晶形態のⅢⅢ族窒化物の結晶が成長可能であることを特徴とするⅢⅢ族窒化物結晶成長方法。

【請求項3】

請求項2記載のⅢⅢ族窒化物結晶成長方法において、複数の領域のうちの1つの領域は、ⅢⅢ族窒化物の結晶成長形態として、種結晶に結晶成長するものであることを特徴とするⅢⅢ族窒化物結晶成長方法。

【請求項4】

請求項2記載のⅢⅢ族窒化物結晶成長方法において、Pを反応容器内の実効的な窒素圧力(Pa)、Tを混合融液の絶対温度(K)、a, bを係数とするとき、成長するⅢⅢ族窒化物の結晶形態は、 $\log P = a / T + b$ で表される境界により規定される領域に応じて決定されることを特徴とするⅢⅢ族窒化物結晶成長方法。

【請求項5】

請求項4記載のⅢⅢ族窒化物結晶成長方法において、 $\log P = a / T + b$ で表される境界は、アルカリ金属のⅢⅢ族金属との比によって制御可能であることを特徴とするⅢⅢ族窒化物結晶成長方法。

【請求項6】

請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載のⅢⅢ族窒化物結晶成長方法において、

種結晶を用いて結晶成長可能な結晶成長条件領域で、 $\text{III}$ 族窒化物の結晶を種結晶を用いて結晶成長させることを特徴とする $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法。

【請求項7】

請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法において、柱状結晶を用いて結晶成長可能な結晶成長条件領域で、 $\text{III}$ 族窒化物の結晶を柱状結晶を用いて結晶成長させることを特徴とする $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法。

【請求項8】

請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法において、板状結晶を用いて結晶成長可能な結晶成長条件領域で、 $\text{III}$ 族窒化物の結晶を板状結晶を用いて結晶成長させることを特徴とする $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法。

【請求項9】

請求項1乃至請求項8のいずれか一項に記載の $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法において、 $\text{III}$ 族窒化物結晶が成長せずに分解する条件領域、種結晶成長する成長条件領域、柱状結晶が成長する成長条件領域、板状結晶が成長する成長条件領域の内、複数の条件領域を利用して、 $\text{III}$ 族窒化物結晶を成長させることを特徴とする $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法。

【請求項10】

請求項9記載の $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法において、 $\text{III}$ 族窒化物結晶が成長せずに分解する条件領域と柱状結晶または板状結晶が成長する成長条件領域とを利用して、 $\text{III}$ 族窒化物結晶を成長させることを特徴とする $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法。

【請求項11】

請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法において、アルカリ金属としてナトリウム(Na)を用い、少なくとも $\text{II}$ 族金属を含む物質としてガリウム(Ga)を用い、少なくとも窒素を含む物質として窒素ガス(N<sub>2</sub>)を用いて、 $\text{III}$ 族窒化物として窒化ガリウム(GaN)を結晶成長させると、窒化ガリウム(GaN)の結晶成長条件を窒素ガス圧力とガリウムとナトリウムの混合融液の温度とで規定することを特徴とする $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法。

【請求項12】

請求項11記載の $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法において、Pを窒素ガス圧力(Pa)、Tを混合融液の絶対温度(K)、 $a_1, b_1, a_2, b_2$ を、 $a_1 = -5.40 \times 10^{-3}$ 、 $b_1 = 4.83$ 、 $a_2 = -5.59 \times 10^{-3}$ 、 $b_2 = 5.47$ の係数とするとき、 $a_1 / T + b_1 \log P$ 、 $a_2 / T + b_2$ で表される結晶成長条件領域で、種結晶を用いて窒化ガリウム(GaN)を結晶成長させることを特徴とする $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法。

【請求項13】

請求項11記載の $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法において、Pを窒素ガス圧力(Pa)、Tを混合融液の絶対温度(K)、 $a_2, b_2, a_3, b_3$ を、 $a_2 = -5.59 \times 10^{-3}$ 、 $b_2 = 5.47$ 、 $a_3 = -5.67 \times 10^{-3}$ 、 $b_3 = 5.83$ の係数とするとき、 $a_2 / T + b_2 \log P$ 、 $a_3 / T + b_3$ で表される結晶成長条件領域で、柱状の窒化ガリウム(GaN)結晶を成長させることを特徴とする $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法。

【請求項14】

請求項11記載の $\text{III}$ 族窒化物結晶成長方法において、Pを窒素ガス圧力(Pa)、Tを混合融液の絶対温度(K)、 $a_3, b_3$ を、 $a_3 = -5.67 \times 10^{-3}$ 、 $b_3 = 5.83$ の係数とするとき、 $a_3 / T + b_3 \log P$ で表される結晶成長条件領域で、板状の窒化ガリウム(GaN)結晶を成長させることを特徴とする $\text{III}$ 族窒化物の結晶成長方法。

【請求項15】

種結晶成長する成長条件領域、柱状結晶が成長する成長条件領域、板状結晶が成長する成長条件領域の内の1つの成長条件領域を選択して $\text{III}$ 族窒化物結晶を成長させるための圧力制御機構及び温度制御機構を有していることを特徴とする $\text{III}$ 族窒化物結晶成長

装置。

【請求項 16】

I II 族窒化物結晶が成長せずに分解する条件領域、種結晶成長する成長条件領域、柱状結晶が成長する成長条件領域、板状結晶が成長する成長条件領域の内、複数の条件領域を利用して I II 族窒化物結晶を成長させるための圧力制御機構及び温度制御機構を有していることを特徴とする I II 族窒化物結晶成長装置。

【請求項 17】

請求項 1 乃至請求項 14 のいずれか一項に記載の I II 族窒化物結晶成長方法で作製されたことを特徴とする I II 族窒化物結晶。

【請求項 18】

請求項 17 記載の I II 族窒化物結晶を用いたことを特徴とする半導体デバイス。

【請求項 19】

請求項 18 記載の半導体デバイスにおいて、該半導体デバイスは、光デバイスであることを特徴とする半導体デバイス。

【請求項 20】

請求項 18 記載の半導体デバイスにおいて、該半導体デバイスは、電子デバイスであることを特徴とする半導体デバイス。

【請求項 21】

アルカリ金属と I II 族金属とを含む混合融液を保持する混合融液保持容器を備える結晶成長装置において前記混合融液保持容器内に窒素を含む物質を供給して I II 族窒化物結晶を製造する I II 族窒化物結晶の製造方法であって、

各々が前記 I II 族窒化物結晶を結晶成長または分解させる結晶成長条件の領域を示す複数の結晶成長領域のうちの少なくとも 1 つの結晶成長領域に含まれる結晶成長条件を設定する第 1 の工程と、

前記設定した結晶成長条件を一定時間保持する第 2 の工程とを備え、

前記結晶成長条件は、前記混合融液保持容器内の圧力と前記混合融液の温度とからなる、I II 族窒化物結晶の製造方法。

【請求項 22】

前記第 1 の工程は、柱状結晶からなる I II 族窒化物結晶を結晶成長させる結晶成長条件を設定する、請求項 21 に記載の I II 族窒化物結晶の製造方法。

【請求項 23】

前記第 1 の工程は、板状結晶からなる I II 族窒化物結晶を結晶成長させる結晶成長条件を設定する、請求項 21 に記載の I II 族窒化物結晶の製造方法。

【請求項 24】

前記第 1 の工程は、種結晶のみに前記 I II 族窒化物結晶が結晶成長する結晶成長条件を設定する、請求項 21 に記載の I II 族窒化物結晶の製造方法。

【請求項 25】

前記種結晶は、前記複数の結晶成長領域のうちの 1 つの結晶成長領域に含まれる結晶成長条件を用いて結晶成長された I II 族窒化物結晶からなる、請求項 24 に記載の I II 族窒化物結晶の製造方法。

【請求項 26】

前記 1 つの結晶成長領域に含まれる結晶成長条件は、柱状結晶を結晶成長させる結晶成長条件である、請求項 25 に記載の I II 族窒化物結晶の製造方法。

【請求項 27】

前記 1 つの結晶成長領域に含まれる結晶成長条件は、板状結晶を結晶成長させる結晶成長条件である、請求項 25 に記載の I II 族窒化物結晶の製造方法。

【請求項 28】

前記第 1 の工程は、  
板状結晶からなる I II 族窒化物結晶を結晶成長させる第 1 の結晶成長条件を設定する第 1 のサブ工程と、

前記ⅠⅠⅠ族窒化物結晶を分解する第2の結晶成長条件を設定する第2のサブ工程と、  
板状結晶からなるⅠⅠⅠ族窒化物結晶を結晶成長させる第3の結晶成長条件を設定する  
第3のサブ工程とを含み、

前記第2の工程は、

前記第1の結晶成長条件を保持する第4のサブ工程と、

前記第2の結晶成長条件を保持する第5のサブ工程と、

前記第3の結晶成長条件を保持する第6のサブ工程とを含み、

前記第4のサブ工程は、前記第1のサブ工程の後に実行され、

前記第2のサブ工程は、前記第4のサブ工程の後に実行され、

前記第5のサブ工程は、前記第2のサブ工程の後に実行され、

前記第3のサブ工程は、前記第5のサブ工程の後に実行され、

前記第6のサブ工程は、前記第3のサブ工程の後に実行される、請求項21に記載のⅠⅠⅠ族窒化物結晶の製造方法。

**【請求項29】**

前記第1の工程は、

柱状結晶からなるⅠⅠⅠ族窒化物結晶を結晶成長させる第1の結晶成長条件を設定する  
第1のサブ工程と、

前記ⅠⅠⅠ族窒化物結晶を分解する第2の結晶成長条件を設定する第2のサブ工程と、

柱状結晶からなるⅠⅠⅠ族窒化物結晶を結晶成長させる第3の結晶成長条件を設定する  
第3のサブ工程とを含み、

前記第2の工程は、

前記第1の結晶成長条件を保持する第4のサブ工程と、

前記第2の結晶成長条件を保持する第5のサブ工程と、

前記第3の結晶成長条件を保持する第6のサブ工程とを含み、

前記第4のサブ工程は、前記第1のサブ工程の後に実行され、

前記第2のサブ工程は、前記第4のサブ工程の後に実行され、

前記第5のサブ工程は、前記第2のサブ工程の後に実行され、

前記第3のサブ工程は、前記第5のサブ工程の後に実行され、

前記第6のサブ工程は、前記第3のサブ工程の後に実行される、請求項21に記載のⅠⅠⅠ族窒化物結晶の製造方法。

**【請求項30】**

前記混合融液保持容器内の圧力をPとし、前記混合融液の絶対温度をTとし、aおよび  
bを定数としたとき、前記複数の結晶成長領域のうちの隣接する2つの結晶成長領域の境  
界は、 $10gP = a / T + b$ によって表される、請求項21から請求項29のいずれか1  
項に記載のⅠⅠⅠ族窒化物結晶の製造方法。

**【請求項31】**

請求項21から請求項30のいずれか1項に記載のⅠⅠⅠ族窒化物結晶の製造方法によ  
って製造されたⅠⅠⅠ族窒化物結晶を用いて作製された半導体デバイス。

**【請求項32】**

当該半導体デバイスは、光デバイスである、請求項31に記載の半導体デバイス。

**【請求項33】**

当該半導体デバイスは、電子デバイスである、請求項31に記載の半導体デバイス。

**【請求項34】**

反応容器と、

前記反応容器内に配置され、前記反応容器内の空間に連通する領域にアルカリ金属とⅠ  
Ⅰ族金属とを含む混合融液を保持する混合融液保持容器と、

前記反応容器内に窒素を含む物質を供給する供給管と、

前記反応容器内をⅠⅠⅠ族窒化物結晶が結晶成長可能な温度に制御する加熱装置と、

前記反応容器内の圧力を調整する圧力調整機構とを備え、

前記加熱装置は、各々が前記ⅠⅠⅠ族窒化物結晶を結晶成長または分解させる結晶成長

条件の領域を示す複数の結晶成長領域のうちの少なくとも1つの結晶成長領域に含まれる結晶成長可能な温度に前記反応容器内を制御し、

前記圧力調整機構は、前記少なくとも1つの結晶成長領域に含まれる結晶成長可能な圧力に前記反応容器内の圧力を調整し、

前記結晶成長条件は、前記反応容器内の圧力と前記反応容器内の温度とからなる、I II I族窒化物結晶成長装置。

【請求項35】

前記加熱装置は、柱状結晶からなるI II I族窒化物結晶を結晶成長可能な温度に前記反応容器内を制御し、

前記圧力調整機構は、前記柱状結晶からなるI II I族窒化物結晶を結晶成長可能な圧力に前記反応容器内の圧力を調整する、請求項34に記載のI II I族窒化物結晶成長装置。

【請求項36】

前記加熱装置は、板状結晶からなるI II I族窒化物結晶を結晶成長可能な温度に前記反応容器内を制御し、

前記圧力調整機構は、前記板状結晶からなるI II I族窒化物結晶を結晶成長可能な圧力に前記反応容器内の圧力を調整する、請求項34に記載のI II I族窒化物結晶成長装置。

【請求項37】

前記加熱装置は、種結晶のみに結晶成長するI II I族窒化物結晶を結晶成長可能な温度に前記反応容器内を制御し、

前記圧力調整機構は、前記種結晶のみに結晶成長するI II I族窒化物結晶を結晶成長可能な圧力に前記反応容器内の圧力を調整する、請求項34に記載のI II I族窒化物結晶成長装置。

【請求項38】

前記種結晶は、前記複数の結晶成長領域のうちの1つの結晶成長領域に含まれる結晶成長条件を用いて結晶成長されたI II I族窒化物結晶からなる、請求項37に記載のI II I族窒化物結晶成長装置。

【請求項39】

前記種結晶は、柱状結晶からなる、請求項38に記載のI II I族窒化物結晶成長装置。

【請求項40】

前記種結晶は、板状結晶からなる、請求項38に記載のI II I族窒化物結晶成長装置。

【請求項41】

前記反応容器内の圧力をPとし、前記反応容器内の絶対温度をTとし、aおよびbを定数としたとき、前記複数の結晶成長領域のうちの隣接する2つの結晶成長領域の境界は、 $\log P = a / T + b$ によって表される、請求項34から請求項40のいずれか1項に記載のI II I族窒化物結晶成長装置。

【請求項42】

反応容器と、

前記反応容器内に配置され、前記反応容器内の空間に連通する領域にアルカリ金属とI II I族金属とを含む混合融液を保持する混合融液保持容器と、

前記反応容器内に窒素を含む物質を供給する供給管と、

前記結晶成長可能な圧力と前記結晶成長可能な温度とによって規定される圧力-温度相関図を記憶する記憶部と、

前記圧力-温度相関図を前記記憶部から読み出して前記反応容器内の圧力および温度をI II I族窒化物結晶を結晶成長可能な圧力および温度に設定するコンピュータとを備えるI II I族窒化物結晶成長装置。

【請求項43】

前記圧力-温度相関図は、各々が前記I II I族窒化物結晶を結晶成長または分解させる結晶成長条件の領域を示す複数の結晶成長領域に分割されている、請求項42に記載のI II I族窒化物結晶成長装置。

【請求項44】

前記複数の結晶成長領域は、

柱状結晶からなるⅢⅢ族窒化物結晶を結晶成長させる結晶成長条件の領域を示す第1の結晶成長領域と、

板状結晶からなるⅢⅢ族窒化物結晶を結晶成長させる結晶成長条件の領域を示す第2の結晶成長領域と、

種結晶のみに前記ⅢⅢ族窒化物結晶が結晶成長する結晶成長条件の領域を示す第3の結晶成長領域と、

前記ⅢⅢ族窒化物結晶を分解する結晶成長条件の領域を示す第4の結晶成長領域とを含む、請求項43に記載のⅢⅢ族窒化物結晶成長装置。

【請求項45】

柱状形状からなるⅢⅢ族窒化物結晶。

【請求項46】

前記柱状形状は、<0001>方向に伸びた形状からなる、請求項45に記載のⅢⅢ族窒化物結晶。

【請求項47】

前記柱状形状の端面は、(0001)面からなる、請求項45に記載のⅢⅢ族窒化物結晶。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0033】

また、請求項12記載の発明は、請求項11記載のⅢⅢ族窒化物結晶成長方法において、  
 $P$ を窒素ガス圧力( $P_a$ )、 $T$ を混合融液の絶対温度( $K$ )、 $a_1, b_1, a_2, b_2$ を  
 $a_1 = -5.40 \times 10^{-3}$ ,  $b_1 = 4.83$ ,  $a_2 = -5.59 \times 10^{-3}$ ,  $b_2 = 5.47$ の係数とするとき、 $a_1 / T + b_1 \log P$   $a_2 / T + b_2$ で表される結晶成長条件領域で、種結晶を用いて窒化ガリウム(GaN)を結晶成長させることを特徴としている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0034

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0034】

また、請求項13記載の発明は、請求項11記載のⅢⅢ族窒化物結晶成長方法において、  
 $P$ を窒素ガス圧力( $P_a$ )、 $T$ を混合融液の絶対温度( $K$ )、 $a_2, b_2, a_3, b_3$ を  
 $a_2 = -5.59 \times 10^{-3}$ ,  $b_2 = 5.47$ ,  $a_3 = -5.67 \times 10^{-3}$ ,  $b_3 = 5.83$ の係数とするとき、 $a_2 / T + b_2 \log P$   $a_3 / T + b_3$ で表される結晶成長条件領域で、柱状の窒化ガリウム(GaN)結晶を成長させることを特徴としている。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0035

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0035】

また、請求項14記載の発明は、請求項11記載のⅢⅢ族窒化物結晶成長方法において、  
 $P$ を窒素ガス圧力( $P_a$ )、 $T$ を混合融液の絶対温度( $K$ )、 $a_3, b_3$ を、 $a_3 = -5.67 \times 10^{-3}$ ,  $b_3 = 5.83$ の係数とするとき、 $a_3 / T + b_3 \log P$  で表

される結晶成長条件領域で、板状の窒化ガリウム（GaN）結晶を成長させることを特徴としている。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0075

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0075】

ここで、Pは窒素ガス圧力（Pa）、Tは混合融液の絶対温度（K）、a1, b1, a2, b2は係数で、 $a_1 = -5.40 \times 10^{-3}$ ,  $b_1 = 4.83$ ,  $a_2 = -5.59 \times 10^{-3}$ ,  $b_2 = 5.47$ である。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0076

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0076】

このように、第12の実施形態は、Pを窒素ガス圧力（Pa）、Tを混合融液の絶対温度（K）、a1, b1, a2, b2を、 $a_1 = -5.40 \times 10^{-3}$ ,  $b_1 = 4.83$ ,  $a_2 = -5.59 \times 10^{-3}$ ,  $b_2 = 5.47$ の係数とするとき、 $a_1 / T + b_1 \log P - a_2 / T + b_2$ で表される結晶成長条件領域で、種結晶を用いて窒化ガリウム（GaN）を結晶成長させるようにしてあり、種結晶を元にしてGaN結晶を成長させることができが、圧力と温度を制御することで可能となる。すなわち、上記の結晶成長条件領域では、種結晶を元にした結晶成長が支配的であり、他の領域への核発生及び結晶成長が殆ど発生しないことから、無駄な原料の消費を抑え、大型のIII族窒化物単結晶を作製することが可能となる。また、種結晶のある所定位置に大型の単結晶を成長させることができる。更に、種結晶の結晶方位を制御することで、成長する結晶の結晶方位も制御することが可能となり、基板として用いる際に意図した結晶方位を使用することが容易となる。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0079

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0079】

ここで、Pは窒素ガス圧力（Pa）、Tは混合融液の絶対温度（K）、a2, b2, a3, b3は係数で、 $a_2 = -5.59 \times 10^{-3}$ ,  $b_2 = 5.47$ ,  $a_3 = -5.67 \times 10^{-3}$ ,  $b_3 = 5.83$ である。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0080

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0080】

このように、第13の実施形態は、Pを窒素ガス圧力（Pa）、Tを混合融液の絶対温度（K）、a2, b2, a3, b3を、 $a_2 = -5.59 \times 10^{-3}$ ,  $b_2 = 5.47$ ,  $a_3 = -5.67 \times 10^{-3}$ ,  $b_3 = 5.83$ の係数とするとき、 $a_2 / T + b_2 \log P - a_3 / T + b_3$ で表される結晶成長条件領域で、柱状の窒化ガリウム（GaN）結晶を成長させるようにしてあり、これにより、良質な柱状結晶を成長させることができとなる。すなわち、上記の結晶成長条件領域では、柱状結晶が支配的に結晶成長することから、面方位が明確となっている。従って、この柱状結晶を元にIII族窒化物基板を作製す

る場合に、面方位の決定、スライスが容易となる利点がある。また、この結晶成長条件領域では、種結晶がなくとも、自発核発生により柱状結晶が成長することから、前述の第12の実施形態で用いる種結晶として、この第13の実施形態の結晶成長条件領域で結晶成長した柱状結晶を使用することができる。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0083

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0083】

ここで、Pは窒素ガス圧力(Pa)、Tは混合融液の絶対温度(K)、a3, b3は係数で、 $a_3 = -5.67 \times 10^{-3}$ ,  $b_3 = 5.83$ である。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0084

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0084】

このように、第14の実施形態は、Pを窒素ガス圧力(Pa)、Tを混合融液の絶対温度(K)、a3, b3を、 $a_3 = -5.67 \times 10^{-3}$ ,  $b_3 = 5.83$ の係数とするとき、 $a_3 / T + b_3 = \log P$ で表される結晶成長条件領域で、板状の窒化ガリウム(GaN)結晶を成長させるようにしてあり、これにより、良質な板状結晶を成長することが可能となる。すなわち、上記の結晶成長条件領域では、板状結晶が支配的に結晶成長することから、III族窒化物基板として用い易い。この板状結晶をそのままIII族窒化物基板として用いることも可能である。あるいは、表面の凹凸がある場合でも、表面研磨するのみでIII族窒化物基板として使用することができる。また、面方位が明確となっていることからも、基板としての使用を容易にすることができます。更に、この結晶成長条件領域での結晶成長では、板状結晶の面方向結晶成長速度が早いことから、効率的にIII族窒化物結晶を成長することができ、低コストにつながる。また、この結晶成長条件領域では、種結晶がなくとも、自発核発生により板状結晶が成長することから、前述の第12の実施形態で用いる種結晶として、この第14の実施形態の結晶成長条件領域で結晶成長した板状結晶を使用することができる。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0113

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0113】

ここで、Pは窒素ガス圧力(Pa)、Tは混合融液の絶対温度(K)、a1, b1は係数で、 $a_1 = -5.40 \times 10^{-3}$ ,  $b_1 = 4.83$ である。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0116

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0116】

ここで、Pは窒素ガス圧力(Pa)、Tは混合融液の絶対温度(K)、a2, b2は係数で、 $a_2 = -5.59 \times 10^{-3}$ ,  $b_2 = 5.47$ である。

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0119

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0119】

ここで、Pは窒素ガス圧力(Pa)、Tは混合融液の絶対温度(K)、a3, b3は係数で、 $a_3 = -5.67 \times 10^{-3}$ ,  $b_3 = 5.83$ である。

【手続補正14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0122

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0122】

具体的に、図1の結晶成長装置を用い、結晶成長条件として、窒素ガス圧力を2MPa、融液温度を850( $1/T = 8.9 \times 10^{-4} K^{-1}$ )にしてGaN結晶成長させた場合、図3に示すような結晶成長となる。すなわち、図1の混合融液103中に種結晶となるGaN結晶301を設置しておき、上記の結晶成長条件(窒素ガス圧力；2MPa、融液温度；850)に保持する。その後、種結晶301を元に、GaN結晶が大きく成長し、成長後のGaN結晶302となる。

【手続補正15】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0129

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0129】

具体的に、図1の結晶成長装置を用い、結晶成長条件として、窒素ガス圧力を3MPa、融液温度を800( $1/T = 9.32 \times 10^{-4} K^{-1}$ )にしてGaN結晶を成長させた場合、図4(a)または図4(b)に示すような柱状結晶401が成長する。すなわち、図1の結晶成長装置において、上記の結晶成長条件(窒素ガス圧力；3MPa、融液温度；800)に保持することで、混合融液103中に図4(a)または図4R>4(b)の形態のGaN結晶401が成長する。

【手続補正16】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0134

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0134】

具体的に、図1の結晶成長装置を用い、結晶成長条件として、窒素ガス圧力を5MPa、融液温度を750( $1/T = 9.77 \times 10^{-4} K^{-1}$ )にしてGaN結晶を成長させた場合、図5に示すような板状結晶501が成長する。すなわち、図1の結晶成長装置において、上記の結晶成長条件(窒素ガス圧力；5MPa、融液温度；750)に保持することで、混合融液103中、及び、融液表面に、図5の形態のGaN結晶501が成長する。

【手続補正17】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0174

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0174】

また、請求項12記載の発明によれば、請求項11記載のIII族窒化物結晶成長方法において、Pを窒素ガス圧力(Pa)、Tを混合融液の絶対温度(K)、a1, b1, a2

,  $b_2$  を、  $a_1 = -5.40 \times 10^{-3}$ ,  $b_1 = 4.83$ ,  $a_2 = -5.59 \times 10^{-3}$ ,  $b_2 = 5.47$  の係数とするとき、  $a_1 / T + b_1 \log P$   $a_2 / T + b_2$  で表される結晶成長条件領域で、 種結晶を用いて窒化ガリウム (GaN) を結晶成長させることにより、 種結晶を元にして GaN 結晶を成長させることができが、 圧力と温度を制御することで可能となる。すなわち、 上記の結晶成長条件領域では、 種結晶を元にした結晶成長が支配的であり、 他の領域への核発生及び結晶成長が殆ど発生しないことから、 無駄な原料の消費を抑え、 大型の III 族窒化物単結晶を作製することが可能となる。また、 種結晶のある所定位置に大型の単結晶を成長させることができる。更に、 種結晶の結晶方位を制御することで、 成長する結晶の結晶方位も制御することが可能となり、 基板として用いる際に意図した結晶方位を使用することが容易となる。

## 【手続補正 18】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0175

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 【0175】

また、 請求項 13 記載の発明によれば、 請求項 11 記載の III 族窒化物結晶成長方法において、  $P$  を窒素ガス圧力 (Pa)、  $T$  を混合融液の絶対温度 (K)、  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $a_3$ ,  $b_3$  を、  $a_2 = -5.59 \times 10^{-3}$ ,  $b_2 = 5.47$ ,  $a_3 = -5.67 \times 10^{-3}$ ,  $b_3 = 5.83$  の係数とするとき、  $a_2 / T + b_2 \log P$   $a_3 / T + b_3$  で表される結晶成長条件領域で、 柱状の窒化ガリウム (GaN) 結晶を成長させることにより、 良質な柱状結晶を成長させることができが可能となる。すなわち、 上記の結晶成長条件領域では、 柱状結晶が支配的に結晶成長することから、 面方位が明確となっている。従って、 この柱状結晶を元に III 族窒化物基板を作製する場合に、 面方位の決定、 スライスが容易となる利点がある。また、 この結晶成長条件領域では、 種結晶がなくとも、 自発核発生により柱状結晶が成長することから、 前述の請求項 12 で用いる種結晶として、 本結晶成長条件領域で結晶成長した柱状結晶を使用することができる。

## 【手続補正 19】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0176

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 【0176】

また、 請求項 14 記載の発明によれば、 請求項 11 記載の III 族窒化物結晶成長方法において、  $P$  を窒素ガス圧力 (Pa)、  $T$  を混合融液の絶対温度 (K)、  $a_3$ ,  $b_3$  を、  $a_3 = -5.67 \times 10^{-3}$ ,  $b_3 = 5.83$  の係数とするとき、  $a_3 / T + b_3 \log P$  で表される結晶成長条件領域で、 板状の窒化ガリウム (GaN) 結晶を成長させることにより、 良質な板状結晶を成長させることができが可能となる。すなわち、 上記の結晶成長条件領域では、 板状結晶が支配的に結晶成長することから、 III 族窒化物基板として用い易い。この板状結晶をそのまま III 族窒化物基板として用いることも可能である。あるいは、 表面の凹凸がある場合でも、 表面研磨するのみで III 族窒化物基板として使用することができる。また、 面方位が明確となっていることからも、 基板としての使用を容易にすることができる。更に、 この結晶成長条件領域での結晶成長では、 板状結晶の面方向結晶成長速度が早いことから、 効率的に III 族窒化物結晶を成長することができ、 低コストにつながる。また、 この結晶成長条件領域では、 種結晶がなくとも、 自発核発生により板状結晶が成長することから、 前述の請求項 12 で用いる種結晶として、 本結晶成長条件領域で結晶成長した板状結晶を使用することができる。